

インフィニオン テクノロジーズ 新製品のご案内

2026 年 5 月



INDEX

バッテリー管理 IC

16ch BMS セルバランシングおよび監視用 IC TLE9016DQK

マイクロコントローラー

車載ボディエレクトロニクス向け TRAVEO™ T2G CYT6BJ シリーズ MCU

パワー

CIPOS™ Prime 1200 V 車載用 CoolSiC™ パワーモジュール

OPTIREG™ PMIC TLE9744QK: トラクションインバーター アプリケーション特化 PMIC

EV 向け EiceDRIVER™ 1EDI304xAS 絶縁ゲートドライバ

FF2000R17T2P8 / FF1400R17T2P8 1700 V、2000 A/1400 A ハーフブリッジ IGBT モジュール、XHP™2 パッケージ

OptiMOS™ 5 (30 V) および OptiMOS™ 6 (40 V) 製品を、ソースダウン構造の PQFN 3.3×3.3 パッケージで拡充し、優れたコストパフォーマンスを実現

OptiMOS™ 7 40 V モーター制御に最適化されたパワー MOSFET

48 V モーター制御、DC-DC コンバーター、車外 LED 照明アプリケーション向け OptiMOS™ 80 V/100 V 上面放熱 SSO10T

OptiMOS™ 7 40 V、SSO4G 5x6 パッケージ

OptiMOS™ 8 ISC019N10NM8SC: SuperSO8 両面放熱 (DSC) パッケージを採用した、100 V n チャネル パワー MOSFET

MV 駆動およびモーター制御用、IGBT7 搭載 EconoPACK™ 3 3

センサー技術

[XENSIV™ TLI55950 増幅型リニア TMR \(トンネル磁気抵抗\) 位置センサー](#)

[XENSIV™ 増幅型リニア TMR \(トンネル磁気抵抗\) 位置センサー](#)

USB

[車載用 USB-C アプリケーション向け EZ-PD™ CCG7S](#)

評価ボード

[REF_10KW_3LBUCK_SiC400: CoolSiC™ MOSFET 400 V G2 を搭載した 3 レベル フライング キャパシタ方式降圧コンバーター リファレンスボード](#)

16ch BMS セルバランシングおよび監視用 IC TLE9016DQK

TLE9016DQK は、車載用 (MHEV、HEV、PHEV、BEV)、産業用 (ESS、データセンター、ロボティクス)、民生用 (e バイク用 BMS、家庭用蓄電) アプリケーション向けリチウムイオン電池パック向けに設計されたマルチチャンネルのバッテリー監視、セルバランシング IC です。セル電圧の測定、温度測定、セルバランシング、メインバッテリーコントローラーとの絶縁通信をサポートします。さらに、安全性の保証に不可欠な診断機能も搭載しています。



主な特長

- > 直列接続された最大 16 個のバッテリーセルのバランシングおよび電圧監視
- > インフィニオンの堅牢な 120V 車載技術による、きわめて過酷な負荷やノイズへの耐性
- > 各セル専用の 16 ビットデルタシグマ($\Delta\Sigma$) ADC により、同期およびフィルタリングされた測定が可能 (内蔵デジタル フィルタリングにより外付部品を最小限に抑えシステムコストを低減)
- > 内部のラウンドロビンサイクルにより安全チェックおよびメカニズムを自動化
- > ASIL-D までの BMS 機能安全要求アプリケーションに対応
- > AURIX™ TC36x/37x/38x 用のインフィニオン Complex Device Driver と互換

競合製品に対する優位性

- > 高精度、高精度な並列 ADC アーキテクチャによりバッテリーパック効率を最大化
- > 数十年にわたる車載分野での経験により、堅牢な 120V 車載技術とスリムな IC 設計により、BMS IC 周りの部品を無駄のない数に抑え、最小レベルのシステムコストを実現
- > インフィニオンの優れた品質は、業界ベンチマークとなる最小レベルの返品率に反映
- > 設計導入の容易化、開発期間短縮、コスト削減を実現する、設定可能な、ASIL-D 準拠のデバイスドライバーが補完的に利用可能

主な利点

- > 堅牢性: インフィニオンのテクノロジーとデバイス アーキテクチャは、最小の外付け部品で、ノイズ下における高い性能を保証
- > 高精度な電圧測定: 信頼性の高い、高精度なバッテリーセル監視により、高精度な SoC および SoH を計測。
- > システムコストを削減: 高い機能統合により、外部 BOM 削減を実現

対象アプリケーション

- > バッテリー式電気自動車 (BEV)
- > マイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV)
- > ハイブリッド車 (HEV)
- > プラグインハイブリッド車 (PHEV)
- > 12V リチウムイオンバッテリーシステム
- > エネルギー ストレージ システム (ESS)

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
TLE9016DQKXUMA1	SP005864101	PG-LQFP-64

【16ch BMS セルバランシングおよび監視用 IC TLE9016DQK】

FAQ

1.	How is accuracy defined in Infineon BMS IC? –Infineon BMS IC EoL accuracy is defined considering the complete cell voltage and temperature range along with soldering drift + external stress factors such as vibration, humidity, etc.
2.	How is the communication performed with multiple Infineon BMS IC? –Infineon BMS IC can be connected with multiple devices in a daisy-chain via capacitive coupled iso UART interface hence without the need of transformer. –The device is capable of ring topology with the transceiver IC, TLE9015DQU
3.	How is NTC measurement performed with Infineon BMS IC? –Infineon implements a unique temperature measurement scheme which the customer can directly connect NTC signals to the respective pin thanks to the integrated current sources.
4.	How can Infineon achieve such high quality performance for BMS IC? –Infineon has a dedicated and proven methodology (Design for Stress) specifically for automotive products –DfS is integrated into product development and production screening to detect early failures to avoid shipping parts with a potential latent defects. –Infineon implements BMS specific measures e.g. stress test ensure robustness even beyond AECQ100 requirements

車載ボディエレクトロニクス向け TRAVEO™ T2G CYT6BJ シリーズ MCU

インフィニオンの TRAVEO™ T2G CYT6BJ シリーズ MCU は、クアッドコア Arm® Cortex®-M7 アーキテクチャを採用し、高い処理性能と信頼性の高いネットワーク接続性を備え、車載ボディエレクトロニクス用途に優れた機能を提供します。本シリーズは、ゾーンコントロール、ボディドメインコントロール、インフォテインメントなど、さまざまな車載アプリケーション向けに最適化されています。CYT6BJ シリーズは、320 MHz 動作のクアッドコアと 16 MB のフラッシュ容量を搭載しています。



主な特長

- > 最大メインコア周波数 320 MHz
- > OTA 向けデュアルバンク対応の 16 MB フラッシュ
- > 低消費電力: DeepSleep 50 µA (typ)
- > 電源電圧範囲: 2.7 V~5.5 V
- > eMMC およびシリアルメモリアインターフェース
- > ISO 26262 ASIL-B 対応
- > サイバーセキュリティ: ISO 21434 準拠
- > 10Base-T1S、最大 1G Ethernet MAC

競合製品に対する優位性

- > ゲートウェイ機能向けの堅牢なネットワークインターフェース
 - 最大 2つの 1G イーサネット、最大 10ch の CAN、最大 20ch の LIN (サイバーセキュリティ対応)
- > ボディゾーン制御向けのサイバーセキュリティおよび機能安全対応
 - ISO 21434 および ISO 26262 に準拠
- > CYT6BJ は、16MB および 2MB メモリへの対応を拡大し、増大するソフトウェアコードと真の FOTA をサポート

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

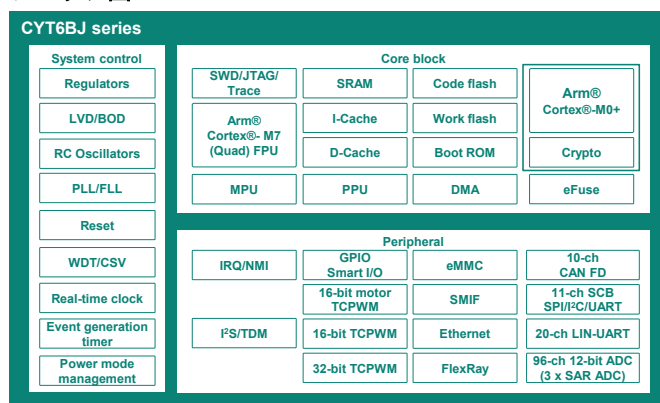
主な利点

- > 最大 2700 DMIPS のクアッドコア
- > ドメインコントロールおよびコネクテッド ゲートウェイ ECU に対応
- > クラス最高レベルの低消費電力モードコントローラー
- > 豊富な接続オプション
- > ISO 26262 の ASIL-B 安全規格に対応
- > 将来を見据えたセキュリティ: eVita Full 準拠の HSM
- > 高速通信インターフェース対応

対象アプリケーション

- > [車載用ボディエレクトロニクスおよび電源分配](#)
- > [車載用ボディ制御モジュール \(BCM\)](#)
- > [ゾーンコントロールユニット](#)

ブロック図



製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
CYT6BJCDHQBQ0BZEGSXQLA1	SP006138088	PG-LFBGA-320

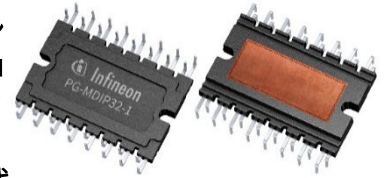
【車載ボディエレクトロニクス向け TRAVEO™ T2G CYT6BJ シリーズ MCU】

FAQ

1. How can I benefit from scalability?	Begin development with target devices and scale your up or down using pin-to-pin compatibility.
2. Who provides security software?	Recommendation to implement third party software.
3. What types of Zone controllers can T2G support?	T2G supports ASIL-B body zone controllers, I/O aggregators, and end- node ECUs. The Multi-domain Zone Controller including ASIL-D supports with AURIX TC4x/TC3x
4. What is important for microcontroller to support Body Zone controller?	What is important for microcontroller to support Body Zone controller? It is necessary to have multiple network interfaces, numerous serial interfaces, flexible I/Os, high efficiency power management, robust cyber security and functional safety in capabilities. T2G Body microcontroller supports all these functions.
5. What is IO aggregator in Zonal architecture?	The IO aggregator reduces wiring complexity and centralizes the handling of various inputs and outputs, making the Zonal architecture more efficient and modular.

CIPOS™ Prime 1200 V 車載用 CoolSiC™ パワーモジュール

CIPOS™ Prime 1200V Automotive CoolSiC™ パワーモジュールは、xEV アプリケーション向けにクラス最高レベルの性能を提供します。車載グレードの CoolSiC™ MOSFET を、コンパクトな完全絶縁モールドパッケージに搭載し、6.6 kW~44 kW のオンボードチャージャーおよび DC/DC トポロジーに対応します。AEC-Q101 および AQG324 の認定取得により、高い信頼性を実現し、ポカヨケ (誤挿入防止) 用のジグザグピン配置と、さらに次世代 EV システム向けの安定供給体制を提供します。



主な特長

- > xEV アプリケーション向け 1200 V 車載グレード CoolSiC™ MOSFET モールド パワーモジュール
- > フルブリッジ構造および 3 相ブリッジ構造の樹脂封止型デュアルインライン (DIL) パッケージ (DIP 44×28mm)
- > 絶縁 DCB 窒化アルミニウム (AlN) パッケージを採用した 4-in-1 および 6-in-1 トポロジー
- > ポカヨケ用にジグザグピン配置の設計を採用したコンパクトで、業界標準のフォームファクター
- > 車載規格 AEC-Q101、AQG324 に準拠
- > 幅広い製品ラインナップ: 3 つのモジュールバリエーションで、11 kW および 22 kW の OBC、DCDC トポロジーに対応
- > 市場標準の競合製品よりも優れた溝入れ加工設計

競合製品に対する優位性

- > インフィニオンの CIPOS™ Prime 1200 V モジュールは、市場で最も広範なラインナップと、ピン互換かつドロップイン交換可能な機能を融合させています。これにより、顧客のリデザイン工数を削減するとともに、優れた CoolSiC™ MOSFET の性能を発揮します。優れたグループ構造とポカヨケ対応したピン配置は、組み立て品質と信頼性という主要な課題に直接対応しています。さらに自動車 OEM 社およびティア 1 サプライヤーは、AEC-Q101 および AQG324 認証と確実な製品供給により、大規模設計への採用に対する確信を得られます。

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

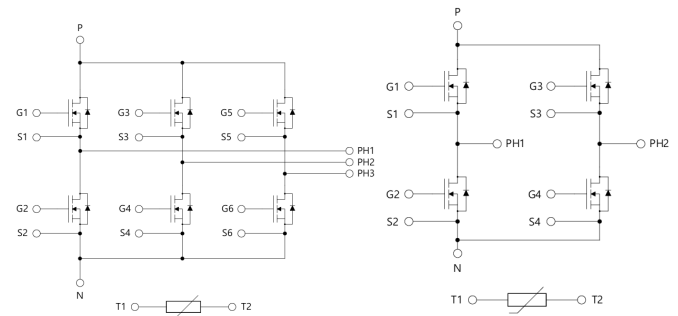
主な利点

- > 最高レベルのモジュールソリューション: 市場標準に準拠し、ジグザグピン配置に対応しているため、設計への組み込みが容易
- > 調達を簡素化: 6.6~44 kW の OBC および DC/DC トポロジーに対応
- > ポカヨケ用ジグザグピン配置: 組立ミスをなくし、生産リスクを低減
- > ドロップイン置換対応: 溝形状を改良し、堅牢性を向上
- > クラス最高レベルの CoolSiC™ MOSFET: 優れたスイッチング性能と高効率を実現

対象アプリケーション

- > オンボードチャージャー (OBC)
- > DC-DC オンバーター
- > HV 熱管理
- > HVAC (暖房、換気、および空調)
- > 産業用モータ制御
- > EV 充電
- > サーバー電源ユニット (PSU)
- > SMPS

ブロック図



製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
AMM12S18LB1ZXKMA1	SP006043202	PG-MDIP-32
AMM12S25LB1ZXKMA1	SP006043500	PG-MDIP-32
AMM12S36LB1ZXKMA1	SP006043512	PG-MDIP-32
AMM12S36LB1Z2ZXKMA1	SP006043506	PG-MDIP-32
AMM12S54LB1ZXKMA1	SP006043518	PG-MDIP-32
AMM12S54LB2ZXKMA1	SP006043524	PG-MDIP-32
AMM12S62LB1ZXKMA1	SP006043533	PG-MDIP-32
AMM12S62LB2ZXKMA1	SP006043552	PG-MDIP-32
AMF12S18LB2ZXKMA1	SP006061250	PG-MDIP-32
AMF12S25LB2ZXKMA1	SP006061254	PG-MDIP-32
AMF12S36LB2ZXKMA1	SP006061258	PG-MDIP-32
AMF12S54LB2ZXKMA1	SP006061262	PG-MDIP-32
AMF12S62LB2ZXKMA1	SP006061266	PG-MDIP-32

OPTIREG™ PMIC TLE9744QK: トラクションインバーター アプリケーション特化 PMIC

TLE9744QK は、トラクションインバーター アプリケーションに特化した PMIC で、レゾルバ励磁回路を内蔵し、MCU の故障時にシステムを安全状態へ移行させる高度なセーフティエンジン (ISL) を搭載しています。高い設定自由度を持つ内蔵セーフティ ロジックにより、6 系統のアナログ入力、5 系統のデジタル入力、ウォッチドッグ、および MCU 監視信号を評価して安全状態を決定します。ASIL-D まで対応します。

価値提案: BOM 点数削減、コスト削減、省スペース化。



主な特長

- > プリレギュレータ 1 および 2: 内部および外部のポストレギュレータ用
- > 3つの LDO および 2つのトラッカー
- > SPI インターフェース
- > レゾルバ励磁回路
- > 統合安全ロジック (ISL)
- > 相電流、DC リンク、ゲートドライバの状態、および MCU クロックの監視
- > トルク制御および DC リンクのアクティブ放電制御
- > ISL およびトラッカー2用の冗長電源入力

主な利点

- > 内蔵インバーター特有の機能
- > 部品点数の削減
- > 部品コストの削減
- > 基板スペースの削減
- > Aurix™、EiceDRIVER™との相互運用性
- > ISO 26262 に準拠して開発されており、ASIL D までのシステムに対応

競合製品に対する優位性

- > トラクションインバーター向け機能により、スリムでコスト効率

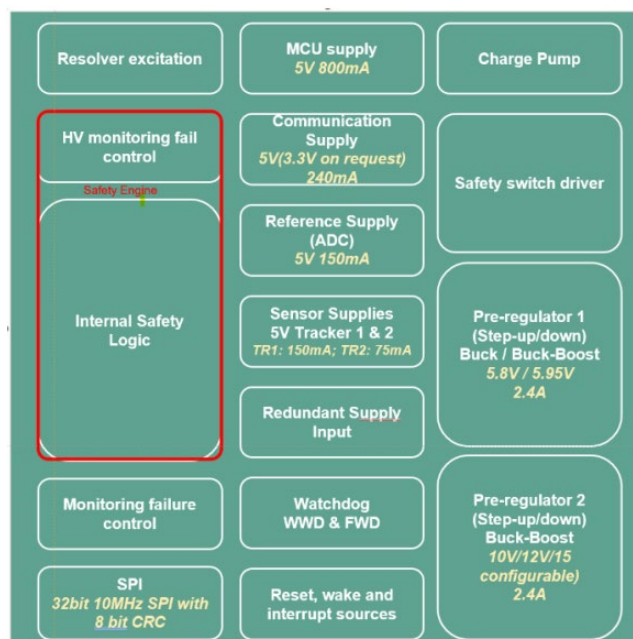
対象アプリケーション

- > トラクションインバーター

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

ブロック図



製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
TLE9744QKXUMA1	SP005343912	PG-LQFP-64

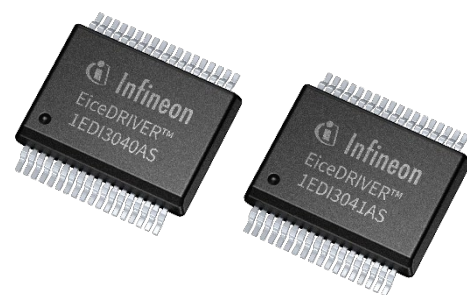
【 OPTIREG™ PMIC TLE9744QK:トラクションインバーター アプリケーション特化 PMIC 】

FAQ

1.	Can the XEV PMIC decide the safe state depending on the motor speed?
	Yes! Once a threshold violation is detected and the MCU does not react, the phase current frequency can be measured and the safe state decided on basis of this measurement.
2.	What is the effort for the software compared to a classic design with a GP PMIC?
	It is slightly higher. The C-MTP values have to be defined and programmed and the reaction (torque matrix) depending on the input parameters for the safety engine.
3.	Can the XEV PMIC be used in a dual motor inverter application?
	Depending on the requirements of the customer yes. We can provide a dual motor concept with the XEV PMIC.

EV 向け EiceDRIVER™ 1EDI304xAS 絶縁ゲートドライバ

EiceDRIVER™ 1EDI3040AS と 1EDI3041AS は、IGBT および SiC トラクションインバータ向けの車載向け 1200 V シングル チャネル ゲートドライバ IC です。強化絶縁に加え、ISO 26262 (ASIL D) 準拠、マルチレベルのスルーレート制御、さらにランタイム中に調整可能なフライバック コントローラ (1EDI3040AS のみ) を備えることで、他にない機能の組み合わせを実現し、優れた顧客価値を提供します。加えて、設計立上げを支援するため、ソフトウェアや各種ツールなど、包括的な設計リソースを提供しています。



主な特長

- > IGBT および SiC MOSFET 向けに設計
- > 高い CMTI (150 V/ns 以上) を有する強化絶縁
- > マルチレベル・スルーレート制御
- > クローズドループ体型フライバックコントローラ (誤差: ±2%以下)
- > ランタイム中の VCC2 電圧調整機能
- > 6 チャンネル絶縁型 ADC
- > 1μs 未満のデジタルフィルタ機能付き DESAT および SOFTOFF
- > パワーデバイスの状態監視

競合製品に対する優位性

- > 強化絶縁に加え、ISO 26262 準拠 (ASIL D)、マルチレベル スルーレート制御、ランタイム中に調整可能なフライバックコントローラ (1EDI3040AS のみ) を備えたこれらの IC は、独自の機能組み合わせにより比類のない顧客メリットを提供します。 benefits

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
1EDI3040EVALBOARDTOBO1	SP006071958	L-MADK-1
1EDI3040EVALHPACKHDTOBO1	SP006185598	L-MADK-1
1EDI3040EVALIDPAKTOBO1	SP006185594	L-MADK-1
1EDI3040ASXUMA1	SP005910755	PG-LFDSO-36
1EDI3041ASXUMA1	SP005910759	PG-LFDSO-36

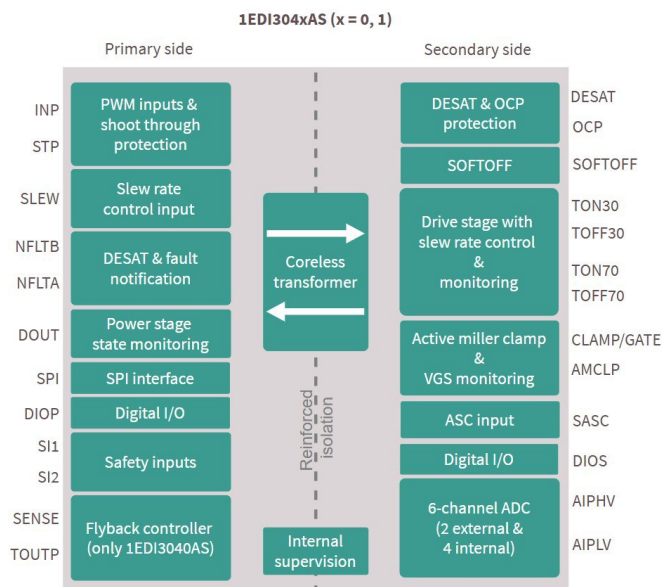
主な利点

- > WLTP 走行サイクルにおいて、インバータ損失を最大 35%低減
- > ブーストモードによりデッドタイムを短縮し、インバータ損失を削減
- > 一体型フライバックコントローラにより、外付け BOM (部品点数) を削減
- > アクティブ VGS 制御により、SiC デバイスの RDS(ON)を最適化
- > 補償付き VDS 測定により、RDS(ON)を高精度に計算
- > 高精度 R_{DS(ON)}を用いて、寿命予測および接合温度 T_j 推定を実現
- > 最速 DESAT により、SiC の性能活用を最大化
- > エンドツーエンドの安全機構により、システム BOM を削減

対象アプリケーション

- > トラクション インバータ

ブロック図



【 EV 向け EiceDRIVER™ 1EDI304xAS 絶縁ゲートドライバ】

FAQ

- | | |
|--|---|
| 1. What devices are 1EDI3040AS/1EDI3041AS designed to drive? | They are 1-channel reinforced isolated gate drivers intended for IGBTs and SiC MOSFETs in xEV traction inverters. |
| 2. What isolation robustness do these drivers provide? | They specify 8 kV reinforced insulation (DIN VDE) and CMTI > 150 V/ns for high dv/dt traction inverter environments. |
| 3. What is common across both variants vs different? | Only difference is the flyback controller |
| 4. What does the <1 us DESAT statement mean in practice? | Documentation states DESAT with digital filtering and cites <1 us short-circuit detection and turn-off. Use the Short Circuit Detection and turn-off AppNote and Safety Manual for the exact timing definition and setup. |
| 5. How do slew-rate control and boost modes help at system level? | Boost mode can reduce dead time and cut SiC body-diode losses, and slew-rate control targets loss savings specially during partial load (e.g., 35% WLTP loss saving) while helping optimize EMC. |
| 6. What monitoring features are supported for SiC health insights? | VDS measurement for sensorless RDS(on) and Tj estimation, active compensation for accurate RDS(on) measurement, and lifetime monitoring and predictive maintenance. |
| 7. What evaluation hardware is available to get started? | For 1EDI3040AS, available kits include 1EDI3040 EVAL BOARD, 1EDI3040 EVAL HPACK_HD, and 1EDI3040 EVAL IDPAK with AURIX(TM)-based GUI and double pulse support. |
| 8. What functional safety collateral is available? | Safety Manual including FMEDA results (both under NDA) |
| 9. What is the program status (samples, PPAP)? | 1EDI3040AS & 1EDI3041AS are released and in production. Samples are also available. |

FF2000R17T2P8 / FF1400R17T2P8 1700 V、2000 A/1400 A ハーフブリッジ IGBT モジュール、XHP™2 パッケージ

XHP™ 2 ハーフブリッジ IGBT モジュール (1700 V、2000 A/1400 A)は、改良チップセット IGBT8/EC8 を採用し、高電力密度設計と熱管理の最適化により、高効率化を実現。



主な特長

- > 並列動作性を向上させるための、IGBT 8 の低ゲート電荷値 QG
- > EmCon 8 のソフトネス向上により、クリーンなスイッチングを実現
- > 熱サイクル耐性の向上と最高性能のための高性能セラミック
- > T_{vj}=175°Cでの連続動作温度

主な利点

- > 高電力密度
- > エネルギー効率
- > 放熱性能の向上
- > スwitching損失と導通損失の低減

競合製品に対する優位性

- > 高電力密度
- > 放熱性能の向上
- > 高効率

対象アプリケーション

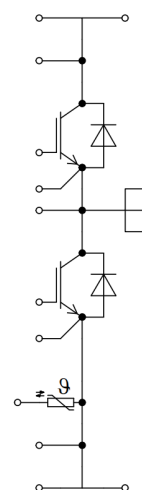
- > ドライブ
- > 太陽光発電
- > 風力発電
- > 蓄電システム
- > 電気分解
- > トラクション

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ: FF2000R17T2P8BPSA1](#)

[製品ページ: FF1400R17T2P8BPSA1](#)

ブロック図

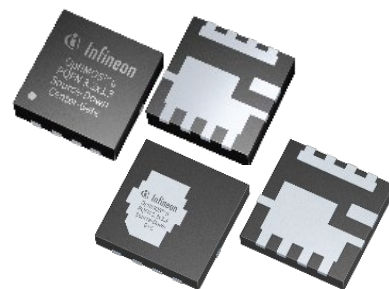


製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
FF2000R17T2P8BPSA1	SP006121939	AG-XHP2K17-831
FF1400R17T2P8BPSA1	SP006121934	AG-XHP2K17-831

OptiMOS™ 5 (30 V) および OptiMOS™ 6 (40 V) 製品を、ソースダウン構造の PQFN 3.3×3.3 パッケージで拡充し、優れたコストパフォーマンスを実現

新しい OptiMOS™ 5 30 V および OptiMOS™ 6 40 V のパワー-MOSFET 製品は、業界標準の高性能 PQFN 3.3×3.3 (ソースダウン/センターゲート) パッケージを採用し、底面放熱 (BSC) および両面放熱 (DSC) に対応します。これにより、基板実装面積が限られる設計でも容易にデザインインが可能。また、価格性能比を最優先したアプローチにより、アプリケーション側で高い電力密度と小型フォームファクタを両立し、機器の小型化、高性能化とユーザー体験の最適化を実現しつつ、優れた価格性能比を提供します。



主な特長

- > 広いゲート電圧範囲
- > 175°Cの温度に対応
- > 競合品と同等クラスの $R_{DS(on)}$
- > 両面放熱のバリエーションを備えたソースダウン パッケージ
- > 優れた価格性能比

主な利点

- > 制御 MOSFET の高速スイッチング
- > 同期整流 MOSFET 向けの低 $R_{DS(on)}$
- > MOSFET の接合温度が高くて、安全で信頼性の高い動作
- > 競合品よりも優れた FOM およびミラー比
- > 優れた放熱性
- > 競争力のある価格

競合製品に対する優位性

- > コスト重視アプリケーション向けの高性能製品
- > 損失低減によりシステムコスト削減と省エネルギーを実現
- > 市場に追加の供給元を提供することで、サプライチェーンを強化
- > 高性能パッケージ: 業界標準 — ソースダウン PQFN 3.3×3.3 (BSC/DSC)
- > 低~中電力レンジ用途に特化して最適化した MOSFET 特性

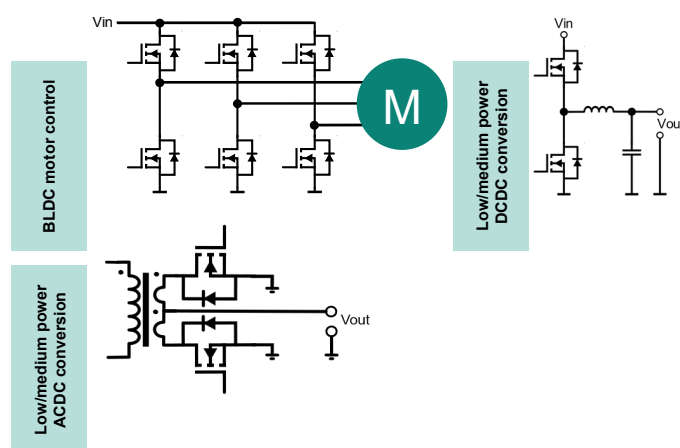
対象アプリケーション

- > BLDC モーター
- > ブラシ付きモーター
- > 補助電源
- > BMS
- > DC-DC コンバーター
- > AC-DC コンバーター
- > 低消費電力デバイス
- > 中出力デバイス

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

ブロック図



製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IQE012N03LM5CGATMA1	SP006150052	PG-TTFN-9
IQE012N03LM5CGSCATMA1	SP006150056	PG-WHTFN-9
IQE020N04LM6CGATMA1	SP006150064	PG-TTFN-9
IQE020N04LM6CGSCATMA1	SP006150069	PG-WHTFN-9

【OptiMOS™ 5 (30 V) および OptiMOS™ 6 (40 V) 製品を、ソースダウン構造の PQFN 3.3×3.3 パッケージで拡充し、優れたコストパフォーマンスを実現】

FAQ

1. Why are the newly introduced parts an easy drop-in replacement?

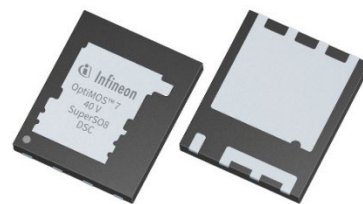
Excellent Miller-ratio, improved FOMs and comparable RDS(on) guarantee operation within design limits, while improving reliability due to reduced device losses and temperature due to better FOMs.

2. In a half-bridge, what are the advantages using a Source-Down package on the low side and a Drain-Down package on the high side?

The large thermal pads of Source- and Drain- Down can be directly connected to the wide PCB copper areas of the power net for easy thermal management. The phase node area is reduced, improving EMI and capacitive coupling lowering losses.

OptiMOS™ 7 40 V モーター制御に最適化されたパワーMOSFET

インフィニオンの OptiMOS™ 7 40 V のモーター制御に最適化 MOSFET は、駆動機器、電動工具、ガーデニングツールでの高効率な電力変換に向けた最適ソリューションを提供します。今回のラインナップ拡充では、新しい 40 V ファミリーに、最高レベルの熱性能とヒートシンク設計の最適化を実現する PQFN 5×6 両面放熱パッケージ品を追加します。



主な特長

- > 業界最小クラスの $R_{DS(on)}$
- > 価格性能比が最適化されたラインナップ
- > 安全動作領域 (SOA) が 3 倍に拡大
- > 短絡電流制限機能
- > 高い最大閾値電圧 3.2 V
- > 電流制御相互コンダクタンス

主な利点

- > 高効率
- > 過酷な環境下での高い耐性
- > パルス電流処理能力の向上
- > 短絡耐性
- > 寄生ターンオン現象に対する高い耐性
- > 固有の短絡電流制限
- > スルーレート制御の向上
- > EMI 特性と操作性の向上

競合製品に対する優位性

- > 導通損失を最大 20%削減し、最小レベルの $R_{DS(on)}$ 値 0.5 m Ω 、前製品に比べ 3 倍広範になった安全動作領域 (SOA) を備えた OptiMOS™ 7 モータードライブは、モーター制御アプリケーションにおいて比類ない効率、信頼性、最適化された価格性能比を実現します。最大 70%制御性が向上し、電流分配の改善、優れた EMI 性能を提供します。新しい DSC シリーズは、最高レベルの電力密度を実現するソリューション向けに、最適化されたヒートシンク設計の可能性を提供します。

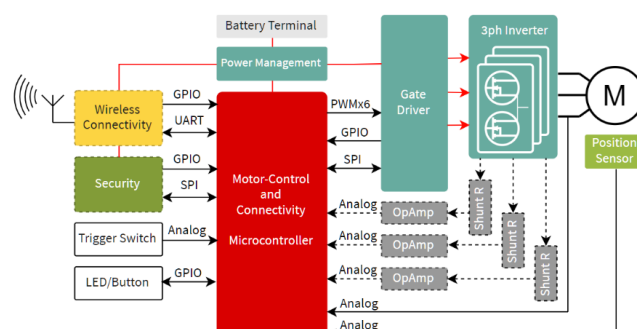
対象アプリケーション

- > [電動工具](#)
- > [コードレス電動工具、屋外用電動機器](#)
- > [コードレス掃除機](#)
- > [ノンスタック BMS ソリューション](#)
- > [最大 72 V までの低出力 BDC/BLDC モーター制御](#)

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

ブロック図



製品概要 (データシートなど) へのアクセス

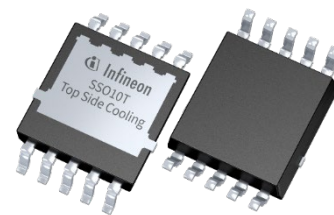
発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
ISCH57N04NM7VSCATMA1	SP006150609	PG-WSON-8
ISCH75N04NM7VSCATMA1	SP006150614	PG-WSON-8
ISCH92N04NM7VSCATMA1	SP006150616	PG-WSON-8

【OptiMOS™ 7 40 V モーター制御に最適化されたパワー-MOSFET】

FAQ	
Q.	How is OptiMOS 7 motor-drive optimized different from generic Power MOSFETs?
A.	Compared with OptiMOS 6 and generic N-channel devices, OptiMOS 7 motor-drive optimized parts provide up to 3x wider SOA, intrinsic short-circuit current limitation, improved pulse current handling, higher V_{th} up to about 3.2 V, and controlled transconductance. This increases robustness under stall and short-circuit, improves current sharing between parallel FETs, and reduces EMI and switching loss
Q.	Which applications are the best fit for this specific 40 V OptiMOS 7 portfolio?
A.	These parts target battery-powered systems and motor drives such as cordless power tools, outdoor power equipment, cordless vacuum cleaners, and non-stackable BMS for Li-ion packs up to 72 V. They fit BLDC and brushed motor inverter stages, battery disconnect or high-side protection switches, and low-voltage DC bus switching where high current and robust SOA are needed.
Q.	How do the different package options (SuperSO8 vs PQFN 3.3 x 3.3) impact my design?
A.	SuperSO8 5x6 devices (ISCH54N04NM7V, ISCH69N04NM7V, ISCH99N04NM7V, ISC011N04NM7V, ISC012N04NM7V, ISC016N04NM7V) deliver very low $R_{DS(on)}$ and high current capability, ideal for high-power motor phases or parallel FETs. ISZ015N04NM7V in PQFN 3.3 x 3.3 offers high power density in a smaller footprint, attractive when PCB area is limited or compact multi-phase designs are needed.
Q.	Can these MOSFETs help me with EMI and switching noise compared to other MOSFET families?
A.	Yes. OptiMOS 7 motor-drive optimized devices use controlled transconductance and improved slew-rate behavior to limit voltage overshoot and ringing. Higher gate threshold voltage and optimized gate charge help avoid unintended turn-on and make it easier to tune gate resistors and snubbers, often reducing EMI filter size and debug effort compared with generic fast-switching MOSFETs.
Q.	Are there evaluation boards or reference designs using OptiMOS 7 available?
A.	Yes, a reference design board using the DSC variant ISCH57N04NM7VSC is available and orderable.
Q.	How should I choose between the different current and $R_{DS(on)}$ options in this group?
A.	Start from your worst-case conditions: pack voltage, continuous and stall phase currents, PWM duty cycle, and allowed temperature rise. Use SOA and $R_{DS(on)}$ curves in the datasheets to ensure margin at high temperature. Higher-current SuperSO8 devices with very low $R_{DS(on)}$ suit demanding tools and large packs, while PQFN 3.3 x 3.3 (ISZ015N04NM7V) fits medium-power stages where space is critical.
Q.	What should I know about availability and long-term supply?
A.	These 40 V OptiMOS 7 N-channel devices sit in Infineon's high-volume industrial MOSFET family. They are intended as standard portfolio parts

48 V モータ制御、DC-DC コンバーター、車外 LED 照明アプリケーション向け OptiMOS™ 80 V/100 V 上面放熱 SSO10T

インフィニオンは、革新的な上面放熱 SSO10T (5×7 mm²) SMD パッケージを採用した車載 MOSFET 製品ラインナップを拡充し、市場初の 100 V 品に加えて、80 V の追加製品を展開します。これらの製品により、要求の厳しい車載アプリケーションにおいて、冷却性能および電力密度の大幅な向上を実現できます。



主な特長

- > 実質的に PCB への熱の流入はほぼ無し
- > エクスポーズパッドの面積が業界最大
- > パッケージ下に配線を引き回せる自由度
- > PCB の裏面に部品の実装が可能
- > 業界最小レベルのオン抵抗値 $R_{DS(on)}$
- > 高速スイッチング (ターンオン/オフ)
- > 小さい閾値電圧 $V_{GS(th)}$ バラツキ
- > 実質的に PCB への熱の流入はほぼ無し

主な利点

- > 優れた熱管理が可能
- > 熱インピーダンス、熱抵抗を 20%~50% 低減
- > ECU の部品または PCB 面積を低減
- > PCB コストの削減に対応 (面積、Cu、バイアス)
- > 高電力密度の実現に対応
- > 導通損失を最小化
- > 優れたスイッチング性能
- > 並列配置に最適

競合製品に対する優位性

- > 市場に先駆けて 100 V の上面放熱対応 SSO10T MOSFET を投入
- > 80 V 上面放熱対応 SSO10T MOSFET の選択肢として、業界で最も広い製品ラインナップ
- > 業界最高水準のオン抵抗 $R_{DS(on)}$
- > 業界最大の露出パッド面積
- > インフィニオンの車載品質と信頼性

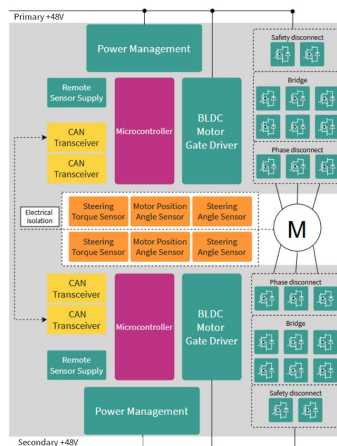
対象アプリケーション

- > [48 V 電動パワーステアリング \(EPS\)](#)
- > [48 V ステアバイワイヤ \(SbW\)](#)
- > [HV-LV DC-DC コンバーター](#)
- > [48 V-12 V DC-DC コンバーター](#)
- > [48 V ポンプおよびファン](#)
- > [LED ヘッドライト](#)
- > [ADAS と自動運転向けのドメインコントローラー](#)
- > [ゾーンコントロールユニット](#)
- > [ヒューマノイドロボット](#)

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

ブロック図



製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IAUCN08S7N016TATMA1	SP005981920	PG-LHDSO-10
IAUCN08S7N019TATMA1	SP005981924	PG-LHDSO-10
IAUCN08S7N024TATMA1	SP005981928	PG-LHDSO-10
IAUCN08S7N036TATMA1	SP006084578	PG-LHDSO-10
IAUCN08S7N045TATMA1	SP005911511	PG-LHDSO-10
IAUCN08S5L160TATMA1	SP006060865	PG-LHDSO-10
IAUCN10S7N025TATMA1	SP006063166	PG-LHDSO-10
IAUCN10S5L110TATMA1	SP006060852	PG-LHDSO-10
IAUCN10S7L290TATMA1	SP006060529	PG-LHDSO-10

【48 V モーター制御、DC-DC コンバーター、車外 LED 照明アプリケーション向け OptiMOS™ 80 V/100 V 上面放熱 SSO10T】

FAQ

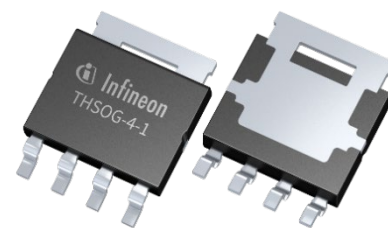
- | |
|--|
| 1. Does Infineon offer top side cooled SSO10T MOSFETs in other breakdown voltages? |
| Yes. 40 V and 100 V OptiMOS MOSFETs are also available in the SSO10T package now. |
| 2. Does Infineon offer top side cooled MOSFETs in other packages? |
| Yes. MOSFETs in the TOLT (10x15mm ²) package are available in 60 V |
| 3. Does Infineon offer OptiMOS 7 80 V automotive MOSFETs in other packages? |
| Yes. OptiMOS 7 80 V products are also available in SSO8 (5x6mm ²), and S3O8 (3x3mm ²), and the TOLL (10x12mm ²) package. This technology is also planned to proliferate to other packages later. |
| 4. Is there a second source option to use as a back up to Infineon? |
| Infineon has listed the package with JEDEC and there are other suppliers of 80 V 5x7mm ² package MOSFETs. |

OptiMOS™ 7 40 V、SSO4G 5x6 パッケージ

インフィニオンの OptiMOS™ 7 40 V、SSO4G 5×6 リード付きパッケージ (PG-THSOG-4-1) は、絶縁金属基板 (IMS: Insulated Metallic Substrate) への実装、従来のリード付きフットプリント設計との互換性を重視しています。

OptiMOS™ 7 40 V SSO4G 5×6 リード付きパッケージ (PG-THSOG-4-1) のオン抵抗範囲は、1.04 mΩ～4.70 mΩです。

また、当社の標準 SSO8 5×6 (PG-TDSON-8) パッケージの幅広い製品群は、将来の車載設計・アプリケーションにおいて性能とコストの両面で最適な選択肢であり、オン抵抗範囲はクラス最小レベルの 0.42 mΩ～4.30 mΩです。



主な特長

- > 5x6 mm² のフットプリント
- > 大電流対応
- > 最新の OptiMOS 7™ 40 V テクノロジー
- > R_{DS(on)} 範囲: 1.0 mΩ ~ 4.7 mΩ
- > IMS および従来のフットプリント設計との互換性を備えた銅クリップを採用したリードパッケージ
- > 高アバランシェ耐性、高 (安全動作領域 (SOA)) 耐久性

主な利点

- > 高電力密度、高効率
- > 放熱効果の高いリードフレームパッケージ
- > 導通損失の低減
- > スイッチング動作の最適化
- > IMS 基板向けの優れたオンボードサーマルサイクル (TCoB) 堅牢性
- > 従来のフットプリント設計との互換性
- > 車載向けの堅牢なパッケージ

競合製品に対する優位性

- > IMS 基板における優れた TCoB
- > 従来のフットプリント設計と 100% 互換

対象アプリケーション

- > IMS 設計
- > 従来の BLCD フットプリント設計

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

ブロック図

標準的な車載用 BLDC モーターアプリケーション



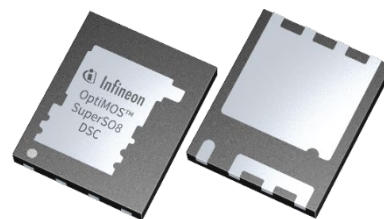
BLDC motor

製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IAUCN04S7N010GATMA1	SP005984384	PG-THSOG-4
IAUCN04S7N015GATMA1	SP005988884	PG-THSOG-4
IAUCN04S7N019GATMA1	SP005988880	PG-THSOG-4
IAUCN04S7N027GATMA1	SP005988868	PG-THSOG-4
IAUCN04S7N037GATMA1	SP005988864	PG-THSOG-4
IAUCN04S7N047GATMA1	SP005988860	PG-THSOG-4
IAUCN04S7L042GATMA1	SP006055284	PG-THSOG-4

OptiMOS™ ISC019N10NM8SC: SuperSO8 両面放熱 (DSC) パッケージを採用した、100 V n チャンネル パワー-MOSFET

両面放熱 SuperSO8 DSC パッケージを採用した OptiMOS™ 8 パワー-MOSFET は、業界標準のフットプリントで、両面放熱ソリューションのあらゆる熱管理上の利点を提供します。



主な特長

- > 業界最小の $R_{DS(on)}$ 、高 ID
- > $V_{GS(th)}$ のばらつきを低減 (1 V 未満) し、低い相互コンダクタンス (g_{fs}) を実現
- > 優れたスイッチング動作とソフト ボディ ダイオード
- > 放熱性能の向上
- > PQFN 5x6 パッケージと互換

主な利点

- > 導通損失を低減し、高い電力密度を実現
- > MOSFET 並列配置時に電流分配を最適化
- > 高耐熱性
- > 使いやすさ

競合製品に対する優位性

- > きわめて低い $R_{DS(on)}$
- > 優れた熱性能
- > 高効率な MOSFET 技術

対象アプリケーション

- > [データセンター、AI データセンター ソリューション](#)
- > [通信インフラ](#)
- > [産業用、民生用 BMS](#)
- > [サーバー電源ユニット \(PSU\)](#)

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
ISC019N10NM8SCATMA1	SP006181056	PG-WSON-8

MV 駆動およびモータ制御用、IGBT7 搭載 EconoPACK™ 3

EconoPACK™ 3 1700 V TRENCHSTOP™ IGBT7 モジュールは、中電圧駆動およびモータ制御向けに、クラス最高レベルの性能を提供します。エミッタ制御の第 7 世代ダイオード、整流器、NTC 温度センサーを絶縁ベースプレート上に統合しており、比類のない信頼性と安定した電源供給を実現します。



主な特長

- > 低 VCEsat (1700 V)、正の温度係数
- > 絶縁ベースプレート
- > RoHS 準拠
- > 定評のある Econo モジュールコンセプト
- > はんだ接合技術
- > NTC 温度センサー内蔵
- > 整流器内蔵

主な利点

- > 高集積化されたシングル モジュール ソリューション
- > スイッチング損失の低減/ジャンクション温度の低減
- > 電力密度の向上
- > 冷却労力の軽減

競合製品に対する優位性

- > 容易な製品設計
- > 最高の価格性能比により、システムコストの削減を実現
- > 次世代パワーモジュール向けに、大幅に向上した電力密度を実現

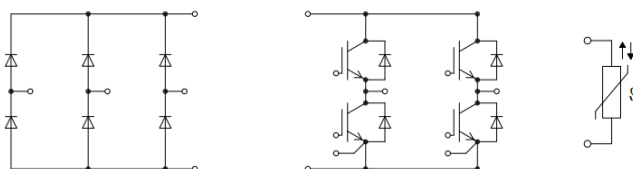
対象アプリケーション

- > 中電圧 (MV) ドライブ
- > [モーター制御](#)

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ページ](#)

ブロック図



製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
F475R17N3E7B58BPSA1	SP006031888	AG-ECONO3B-711

XENSIV™ TLI55950 増幅型リニア TMR (トンネル磁気抵抗) 位置センサー

XENSIV™ TLI55950 は、高度な TMR 技術とオペアンプを内蔵した、増幅型のリニア位置センサーです。超低ノイズかつ高感度で、高精度な磁気センシングを実現します。小型で汎用性が高く、電動工具からロボティクスまで、産業用/民生用アプリケーションヘシームレスに統合できます。



主な特長

- > SOT23-6 パッケージのリニア位置センサー
- > 電源電圧: 5 V および 3.3 V
- > 磁界範囲: $\pm 41/25$ および $\pm 25/16$ mT
- > 最大感度 85.5 mV/mT
- > 超低ノイズ (最大 8.1 μ TRMS)
- > JEDEC JESD47 規格準拠

主な利点

- > 高精度かつ高感度
- > コンパクトで汎用性の高いパッケージ
- > 低消費電力
- > ノイズ低減による正確な測定値
- > 幅広いアプリケーションで信頼性の高い性能を発揮
- > 高い感度が求められるアプリケーションにおいて高い価格性能比を実現

競合製品に対する優位性

- > TMR 方式の磁気センシング技術
- > オペアンプ内蔵
- > 広範囲の磁界に対応で高ダイナミックレンジを実現
- > 温度補償および事前校正済み
- > 高い耐ノイズ性
- > 産業用および民生用アプリケーションに幅広く対応

対象アプリケーション

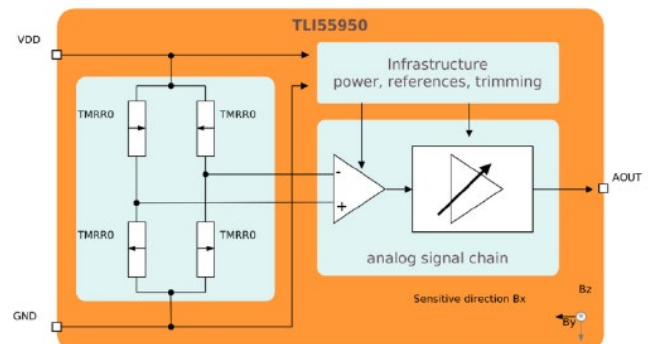
- > 電動工具のトリガー検知
- > サービスロボットおよびドローンの角度検知
- > 高精度デュアル エンコーダ構成
- > 低消費電力アプリケーション
- > 産業用オートメーション

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

[製品ページ](#)

ブロック図



製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
TLI55950A6EE0002XTSA1	SP006206460	PG-SOT23-6

XENSIV™ TLI55910 増幅型リニア TMR (トンネル磁気抵抗) 位置センサー

XENSIV™ TLI55910 は、高度な TMR 技術とオペアンプを内蔵した、増幅型のリニア位置センサーです。超低ノイズかつ高感度で、高精度な磁気センシングを実現します。小型で汎用性が高く、電動工具からロボティクスまで、産業用/民生用アプリケーションヘシームレスに統合できます。



主な特長

- > SOT23-6 パッケージのリニア位置センサー
- > 電源電圧: 5 V および 3.3 V
- > 磁界範囲: $\pm 41/25$ および $\pm 25/16$ mT
- > 最大感度 85.5 mV/mT
- > 超低ノイズ (最大 8.1 μ TRMS)
- > JEDEC JESD47 規格準拠

主な利点

- > 高精度かつ高感度
- > コンパクトで汎用性の高いパッケージ
- > 低消費電力
- > ノイズ低減による正確な測定値
- > 幅広いアプリケーションで信頼性の高い性能を発揮
- > 高い感度が求められるアプリケーションにおいて高い価格性能比を実現

競合製品に対する優位性

- > 高い精度を実現するインフィニオン独自の VortexTMR 技術
- > 低消費電力 (1.8 Vdd 時 0.25 mA)
- > 広い磁界ダイナミックレンジ (± 35 mT)
- > 高いレシオメトリック出力感度 (5 mV/V/mT)
- > 省スペース設計のコンパクトな PG-SOT23-6-4 パッケージ

対象アプリケーション

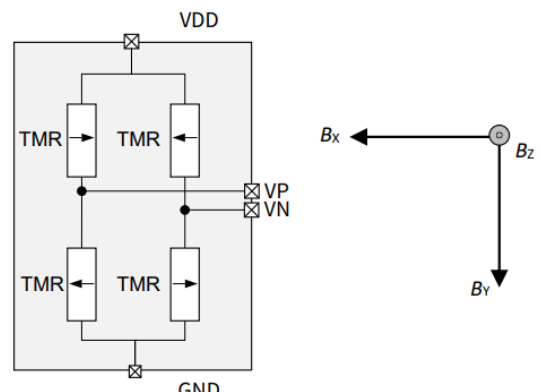
- > ドローン
- > 産業オートメーション
- > ホーム/ビルオートメーション
- > ロボティクス/ロボットシステム

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

[製品ページ](#)

ブロック図



製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
TLI55910A6EE0001XTSA1	SP006118939	PG-SOT23-6

車載用 USB-C アプリケーション向け EZ-PD™ CCG7S

インフィニオンは、車載用 USB Type-C アプリケーション向けに、USB-C PD コントローラー、昇降圧コンバーター、4つのスイッチング FET を統合した EZ-PD™ CCG7S ファミリーから新たなデバイスを発表しました。新デバイスはシステム BOM を削減し、PCB フットプリントの最適化に寄与します。内蔵フラッシュを備えた ARM® Cortex®-M0 アーキテクチャを採用し、最新の PD3.2 規格に準拠するとともに、OEM 各社のカスタム要件にも対応します。



主な特長

- > USB-PD、昇降圧、MOSFET×4 (($R_{DS(on)}$ Typ.: 9 mΩ)
- > USB-PD v3.2 準拠
- > ARM® Cortex®-M0 搭載、SRAM 16KB、Flash 128KB、SCB×3、GPIO×13
- > 故障保護および湿気検知に対応
- > 診断および通信向けに LIN 対応
- > ブラックボックスや動的電力共有などの高度なソフトウェア機能
- > コンパクトな 6.5×9.25mm、40ピン LGA パッケージ

主な利点

- > 高集積ソリューションによりシステム BOM を削減
- > プログラム機能でカスタム システム要件に対応
- > 柔軟なインターフェースにより、USB-C モジュールでの診断が可能
- > ヒートシンクなしの 65W 設計、ヒートシンクありの 100W 設計
- > 迅速な市場投入が可能
- > ヘッドユニット、後席用充電器、後席用エンターテインメントシステムに対応

競合製品に対する優位性

- > 高性能スイッチング MOSFET を内蔵し、高い集積性を実現
- > 優れた放熱性と効率性を発揮すると同時に、BOM コストを削減
- > 内蔵フラッシュメモリと ARM® Cortex®-M0 を搭載し、柔軟なシステムカスタマイズが可能

対象アプリケーション

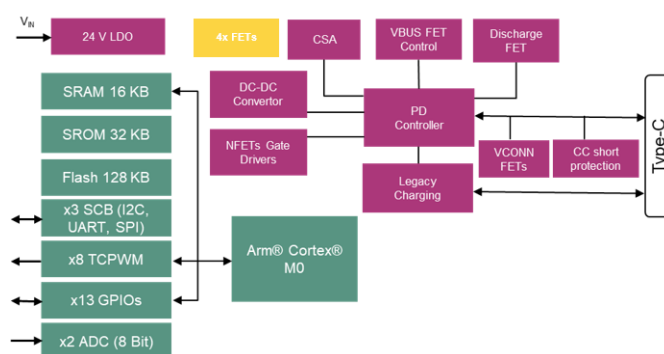
- > ヘッドユニット (HU) 用充電器
- > リアシート用充電器 (RSC)
- > リアシート用エンターテインメントシステム (RSE)

製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

ブロック図

Sync buck:



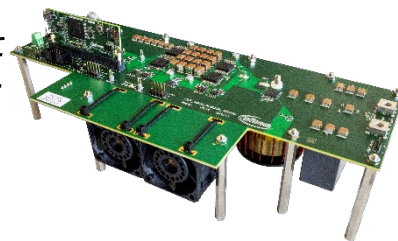
製品概要 (データシートなど) へのアクセス

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
CYPD719440BFXSXQLA1	SP006142927	PG-TFLGA-40
CYPD719440BFXSTXUMA1	SP006142929	PG-TFLGA-40
CYPD719540BFXSXQLA1	SP006142937	PG-TFLGA-40
CYPD719540BFXSTXUMA1	SP006142939	PG-TFLGA-40
CYPD719640BFXSXQLA1	SP006142956	PG-TFLGA-40
CYPD719640BFXSTXUMA1	SP006142958	PG-TFLGA-40

REF_10KW_3LBUCK_SiC400: CoolSiC™ MOSFET 400 V G2 を搭載した 3 レベル フライイング キャパシタ方式降圧コンバーター リファレンスボード

SS

リファレンスボード REF_10KW_3LBUCK_SiC400 は、3 レベル フライイング キャパシタ方式の降圧 DC/DC コンバーターを採用し、2 レベル降圧 DC/DC コンバーターとして再構成し使用することもできます。本プラットフォームの主な目的は、TOLL パッケージおよび D2PAK-7 パッケージの CoolSiC™ MOSFET 400 V/650 V G2 の評価です。本リファレンス設計はさらに、転流およびゲートループを最適化するレイアウト指針を提供し、マルチレベル トポロジにおけるフローティング ゲートドライブ用補助電源、起動、プリチャージ、ならびにフライイングキャパシタの電圧バランシングに関するソリューションも提供します。3 レベル (3L) と 2 レベル (2L) トポロジーの公平なベンチマークを可能にすることで、3 レベルトポロジーの利点を評価できます。



主な特長

- > CoolSiC™ MOSFET 400 V/650 V G2 MOSFET の評価
- > 3 レベルと 2 レベル トポロジーの比較
- > フライイング キャパシタの電圧バランシングアルゴリズム
- > コンパクトかつ低コストなプレーナートランスゲート電源
- > バイポーラとユニポーラのゲート駆動の比較
- > 調整可能なゲート駆動電圧
- > ケルビンソースおよびパワーソースのゲート駆動リファレンスに対応
- > 低インダクタンス、高出力 PCB 設計

主な利点

- > インダクタの電圧スイングを低減 (-50%)
- > リップル周波数は MOSFET のスイッチング周波数の 2 倍
- > インダクタンス値を 75%低減
- > 高効率化に最適化されたインダクタ設計
- > インダクタの小型化により電力密度を向上
- > MOSFET のブロッキング電圧を低減
- > スwitching損失を大幅に削減

競合製品に対する優位性

- > CoolSiC™ MOSFET 400V/650V G2 評価用プラットフォーム。
- > アウターリードの MOSFET (QH50/QL50) を 2 レベル動作に切り替えることで、3 レベル (3L) と 2 レベル (2L) トポロジーのベンチマークが可能
- > フライイングキャパシタのバランシングアルゴリズム
- > 4 つの高周波レグ MOSFET 向けに、低コスト、省スペースなディスクリットプレーナートランス方式の絶縁補助ゲートドライブ電源を搭載
- > 駆動電圧の調整が可能で、バイポーラ/ユニポーラのゲートドライブ評価に対応
- > ゲートドライブ基準をケルビンソース (KS: 4 端子ドライブ) / パワーソース (PS: 3 端子ドライブ) から選択可能
- > 放熱用ヒートシンクを備えた高電力設計において、転流ループおよびゲートループのインダクタンスを低減

対象アプリケーション

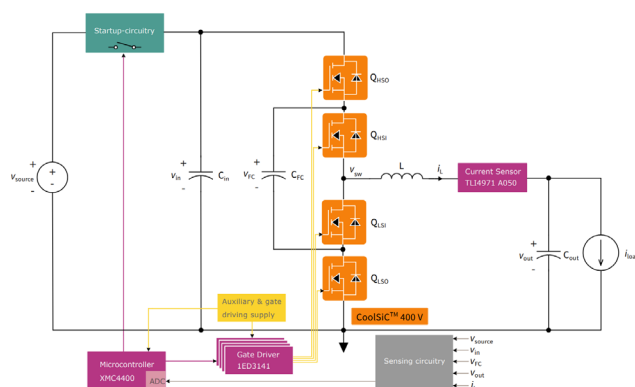
- > [電源バックアップ装置 \(BBU、CBU\)](#)
- > [サーバー用電源ユニット \(PSU\)](#)
- > [太陽光発電](#)
- > [バッテリー蓄電システム \(BESS\)](#)
- > [モーター制御](#)
- > [無停電電源装置 \(UPS\)](#)

製品関連情報/オンラインサポート

[ボードページ](#)

製品概要 (ユーザーガイドなど) へのアクセス

ブロック図



発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
REF10KW3LBUCKSiC400TOBO1	SP006135438	L-MADK-1